

PAD SERIES

PICO AMPERE DIODES

FEATURES

DIRECT REPLACEMENT FOR SILICONIX PAD SERIES

REVERSE BREAKDOWN VOLTAGE $BV_R \geq -30V$

REVERSE CAPACITANCE $C_{RSS} \leq 2.0pF$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS¹

@ 25 °C (unless otherwise stated)

Maximum Temperatures

Storage Temperature -65 to +150 °C

Operating Junction Temperature -55 to +135 °C

Maximum Power Dissipation

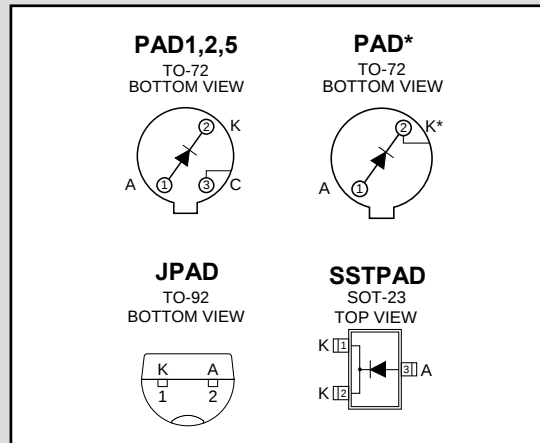
Continuous Power Dissipation (PAD) 300mW

Continuous Power Dissipation (J/SSTPAD) 350mW

Maximum Currents

Forward Current (PAD) 50mA

Forward Current (J/SSTPAD) 10mA



* Cathode tied to Case

COMMON ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25 °C (unless otherwise stated)

SYMBOL	CHARACTERISTIC	MIN	TYP	MAX	UNITS	CONDITIONS
BV_R	Reverse Breakdown Voltage	ALL PAD	-45		V	$I_R = -1\mu A$
		ALL SSTPAD	-30			
		ALL JPAD	-35			
V_F	Forward Voltage		0.8	1.5		$I_F = 5mA$
C_{RSS}	Total Reverse Capacitance	PAD1,5	0.5	0.8	pF	$V_R = -5V, f = 1MHz$
		All Others	1.5	2		

SPECIFIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25 °C (unless otherwise stated)

SYMBOL	CHARACTERISTIC	PAD ²	JPAD ²	SSTPAD ²	UNITS	CONDITIONS
I_R	Maximum Reverse Leakage Current ²	(SST/J)PAD1	-1		pA	$V_R = -20V$
		(SST/J)PAD2	-2			
		(SST/J)PAD5	-5	-5		
		(SST/J)PAD10	-10	-10		
		(SST/J)PAD20	-20	-20		
		(SST/J)PAD50	-50	-50		
		(SST/J)PAD100	-100			
		(SST/J)PAD200	-200			
		(SST/J)PAD500	-500			

Figure 1. Operational Amplifier Protection

Input Differential Voltage limited to 0.8V (typ) by JPADs D₁ and D₂. Common Mode Input voltage limited by JPADs D₃ and D₄ to $\pm 15V$.

Figure 2. Sample and Hold Circuit

Typical Sample and Hold circuit with clipping. JPAD diodes reduce offset voltages fed capacitively from the JFET switch gate.

FIGURE 1

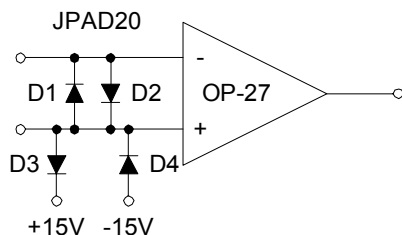
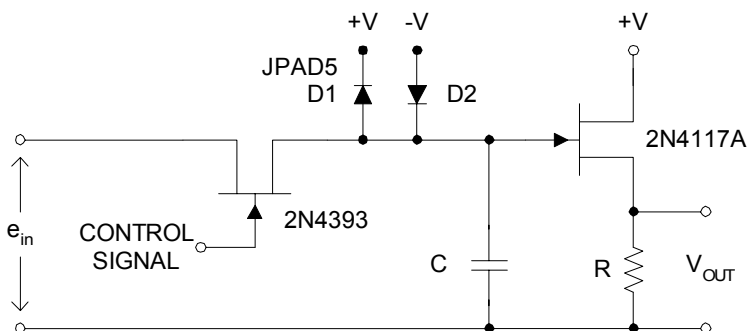
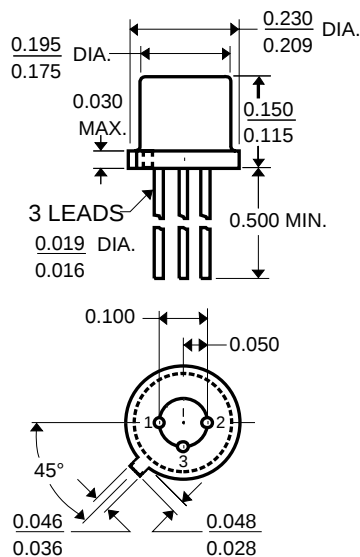


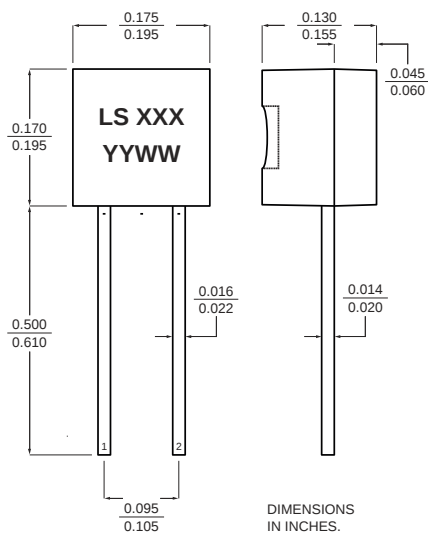
FIGURE 2



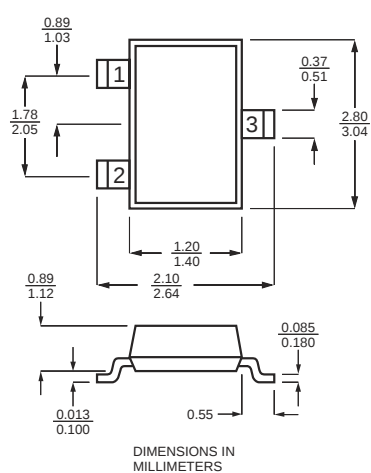
TO-72 Three Lead



TO-92



SOT-23



1. Absolute maximum ratings are limiting values above which serviceability may be impaired.
2. The PAD type number denotes its maximum reverse current value in pico amperes. Devices with I_R values intermediate to those shown are available upon request.

Information furnished by Linear Integrated Systems is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Linear Integrated Systems.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.